

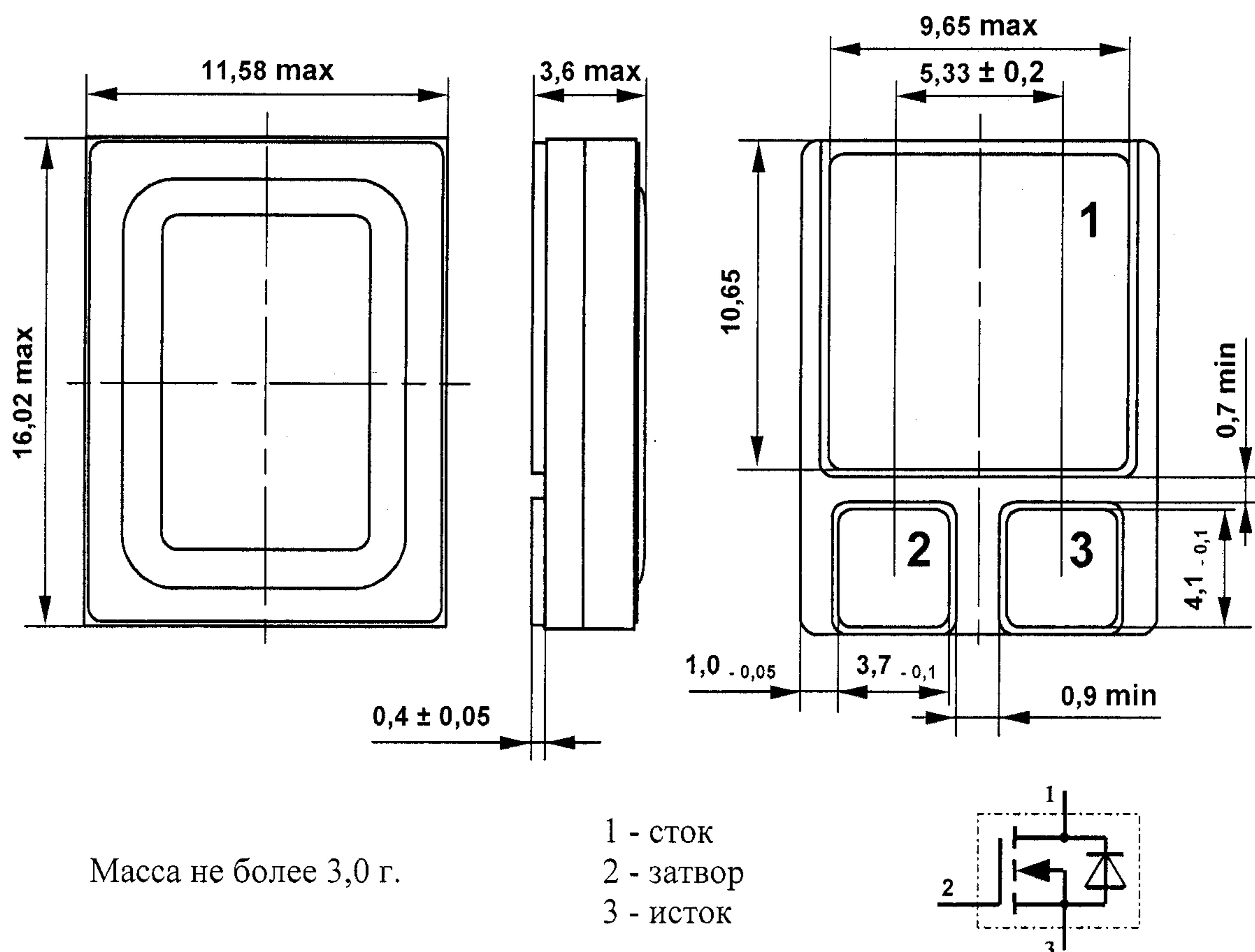
**КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ N КАНАЛЬНЫЕ  
ДМОП ТРАНЗИСТОРЫ**

**2П820А9  
2П820Б9**

АЕЯР. 432140. 311 ТУ

Кремниевые эпитаксиально - планарные N – канальные с изолированным затвором (ДМОП) переключательные мощные транзисторы 2П820А9, 2П820Б9 в металлокерамическом корпусе КТ-94 предназначены для монтажа на поверхность печатных плат в аппаратуре специального назначения.

**2П820А9**



**Стойкость к внешним воздействующим факторам**

**Синусоидальная вибрация:**

диапазон частот .....	(1...5000) Гц
амплитуда ускорения .....	40 g

**Механический удар одиночного действия:**

пиковое ударное ускорение .....	1500 g
длительность действия ударного ускорения .....	(0,1...2,0) мс

**Механический удар многократного действия:**

пиковое ударное ускорение .....	150 g
длительность действия ударного ускорения .....	(1...5) мс

**КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ Н КАНАЛЬНЫЕ  
ДМОП ТРАНЗИСТОРЫ**

**2П820А9**

**Акустический шум:**

диапазон частот .....	(50 – 10000) Гц
уровень звукового давления (относительно $2 \cdot 10^{-5}$ Па) .....	170 дБ
<b>Линейное ускорение:</b>	
значение линейного ускорения .....	500 г
<b>Повышенная рабочая температура корпуса .....</b>	<b>125°C</b>
<b>Пониженная рабочая температура среды .....</b>	<b>минус 60°C</b>
<b>Изменение температуры среды .....</b>	<b>от минус 60°C до 125°C</b>
<b>Атмосферное пониженное рабочее давление *</b> .....	<b>250 мм рт ст</b>

Примечание: \* - допускается работа транзисторов при рабочем пониженном давлении при уменьшении рабочего напряжения сток — исток в соответствии с рисунками.

**Электрические параметры и тепловое сопротивление  
транзисторов**

**Начальный ток стока**

( $U_{zi} = 0$ , $U_{ci} = 720$ В, $t_{корп} = (-60 \pm 3)^\circ\text{C}$ ) не более .....	<b>1,00 мА</b>
( $U_{zi} = 0$ , $U_{ci} = 800$ В, $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ) не более .....	<b>0,01 мА</b>
( $U_{zi} = 0$ , $U_{ci} = 800$ В, $t_{корп} = (125 \pm 5)^\circ\text{C}$ ) не более .....	<b>0,12 мА</b>

**Ток утечки затвора**

( $U_{zi} = 25$ В, $U_{ci} = 0$ , $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ) не более .....	<b>100 нА</b>
( $U_{zi} = -25$ В, $U_{ci} = 0$ , $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ) не менее .....	<b>-100 нА</b>

**Пороговое напряжение**

( $I_c = 1,0$ мА, $U_{zi} = U_{ci}$ , $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ) не менее .....	<b>2 В</b>
( $I_c = 1,0$ мА, $U_{zi} = U_{ci}$ , $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ) не более .....	<b>4 В</b>

**Сопротивление сток - исток в открытом состоянии**

( $I_c = 1$ А, $U_{zi} = 10$ В, $t_{корп} = (-60 \pm 3)^\circ\text{C}$ ) не более .....	<b>0,7 Ом</b>
( $I_c = 1$ А, $U_{zi} = 10$ В, $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ) не более .....	<b>1,0 Ом</b>
( $I_c = 1$ А, $U_{zi} = 10$ В, $t_{корп} = (125 \pm 5)^\circ\text{C}$ ) не более .....	<b>2,0 Ом</b>

**Тепловое сопротивление переход – корпус**

( $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ) не более .....	<b>1,0°C/Вт</b>
---	-----------------

**Входная ёмкость**

( $U_{ci} = 25$ В, $U_{zi} = 0$ , $f = 1$ мГц, $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ) типовое .....	<b>3400 пФ</b>
---	----------------

**Выходная ёмкость**

( $U_{ci} = 25$ В, $U_{zi} = 0$ , $f = 1$ мГц, $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ) типовое .....	<b>200 пФ</b>
---	---------------

**Проходная ёмкость**

( $U_{ci} = 25$ В, $U_{zi} = 0$ , $f = 1$ мГц, $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ) типовое .....	<b>90 пФ</b>
---	--------------

**КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ Н КАНАЛЬНЫЕ  
ДМОП ТРАНЗИСТОРЫ**

**2П820А9**

**Время задержки включения**

(Uси = 30 В, Uзи = 10 В, Ic = 2,7 А, tкорп = (25 ± 10)°C типовое ..... **30 нс**

**Время нарастания**

(Uси = 30 В, Uзи = 10 В, Ic = 2,7 А, tкорп = (25 ± 10)°C типовое ..... **120 нс**

**Время задержки выключения**

(Uси = 30 В, Uзи = 10 В, Ic = 2,7 А, tкорп = (25 ± 10)°C типовое ..... **500 нс**

**Время спада**

(Uси = 30 В, Uзи = 10 В, Ic = 2,7 А, tкорп = (25 ± 10)°C типовое ..... **150 нс**

**Максимально допустимая энергия лавинного пробоя**

(Up = 200 В, Iлав = 7,5 А, Lc = 27 мГн, Rз = 20 Ом, tп нач = 25°C,  
tкорп = (25 ± 10)°C не более ..... **830 мДж**

**Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации**

**Максимально допустимое напряжение сток - исток <sup>1</sup>** ..... **800 В**

**Максимально допустимое напряжение сток - исток <sup>2</sup>** ..... **800 В**

**Максимально допустимое напряжение сток - исток <sup>3</sup>** ..... **720 В**

**Максимально допустимое напряжение затвор - исток** ..... **± 25 В**

**Максимально допустимый постоянный ток стока <sup>1</sup>** ..... **7,5 А**

**Максимально допустимый импульсный ток стока**  
(ти ≤ 300 мкс, Q ≥ 100) <sup>1</sup> ..... **30 А**

**Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность**  
(от - 60°C до 25°C) <sup>4</sup> ..... **125 Вт**

**Максимально допустимая температура перехода** ..... **150°C**

Примечания: <sup>1</sup> - при температуре корпуса tкорп = (25 ± 10)°C;

<sup>2</sup> - при температуре корпуса tкорп = 125°C;

<sup>3</sup> - при температуре корпуса tкорп = - 60°C;

<sup>4</sup> - максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт, в диапазоне температур корпуса от 25°C до 125°C вычисляется по формуле:

$$P_{корп\ макс} = (t_{п\ макс} - t_{корп}) / R_{т п-к}$$

где: - tп макс – максимально допустимая температура перехода;

- tкорп - температура корпуса;

- Rт п-к = 1,0°C/Bт – тепловое сопротивление переход – корпус.

### **Стойкость к воздействию одиночных импульсов напряжения**

Максимально - допустимое положительное (на затворе) импульсное напряжение по цепи затвор - исток при длительности одиночного импульса 0,25; 1,0 и 10,0 мкс не более 80 В;

Максимально - допустимое отрицательное (на затворе) импульсное напряжение по цепи затвор - исток при длительности одиночного импульса 0,25; 1,0 и 10,0 мкс не более 80; 80 и 70 В соответственно;

Максимально - допустимая энергия при отрицательном (на затворе) импульсе напряжения по цепи затвор - исток при длительности одиночного импульса 0,25; 1,0 и 10,0 мкс не более 0,005; 0,02 и 0,2 мДж соответственно;

Максимально - допустимое положительное (на стоке) импульсное напряжение по цепи сток - исток при длительности одиночного импульса 0,25; 1,0 и 10,0 мкс не более 760; 760 и 780 В соответственно;

Максимально - допустимая энергия при положительном (на стоке) импульсе воздействия 0,25; 1,0 и 10,0 мкс по цепи сток - исток 7,6; 32 и 373 мДж соответственно;

Максимально-допустимый импульсный ток стока при отрицательном (на стоке) импульсе воздействия по цепи сток - исток 0,25; 1,0 и 10,0 мкс не более 640; 640 и 240 А соответственно;

Максимально - допустимая энергия при отрицательном (на стоке) импульсе воздействия 0,25; 1,0 и 10,0 мкс по цепи сток - исток 10; 30 и 31 мДж соответственно.

### **Электрические параметры транзисторов, изменяющиеся в течение минимальной наработки**

#### **Начальный ток стока,**

( $U_{ZI} = 0$ ,  $U_{CI} = 800$  В,  $t_{CORP} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ) не более ..... **0,5 мА**

#### **Требования к надежности**

**Минимальная наработка ( $t_{PER} = t_{PER \text{ макс}}$ ) ..... 50000 ч**

#### **Минимальная наработка в облегченных режимах**

( $U_{CI} = 0,7 U_{CI \text{ макс}}$ ,  $I_C = 0,5 I_C \text{ макс}$ ,  $t_{CORP} = (65 \pm 5)^\circ\text{C}$ ) ..... **150000 ч**

**Минимальный срок сохраняемости транзисторов ..... 25 лет**

### **Указания по применению и эксплуатации.**

Указания по применению и эксплуатации транзисторов по ГОСТ В 28146, ОСТ 11 336.907.0 и РД 11. 336.935 со следующими дополнениями и уточнениями.

Основное назначение транзистора – предназначен для использования в качестве электронного ключа в аппаратуре специального назначения.

Транзисторы чувствительны к воздействию статического электричества – допустимое значение электростатического потенциала не более 1000 В.

При использовании двух источников напряжения питания транзисторов:

- при включении: сначала подключают вывод затвора, а затем вывод стока, или одновременно;
- при выключении: сначала отключают вывод стока, а затем вывод затвора, или одновременно.

Допускается параллельное включение транзисторов. При этом необходимо использовать транзисторы с разницей значений порогового напряжения не более 0,3 В. Для предотвращения «звона» при выключении рекомендуется в цепи затворов транзисторов включать резисторы номиналом (10 – 100) Ом. С целью обеспечения равномерного прогрева линейки транзисторов необходимо устанавливать их на общий теплоотвод и, по возможности, ближе друг к другу.

Для влагозащиты плат с транзисторами рекомендуется применять лак марки УР-231 по ТУ 6-21-14 и ЭП-730 по ГОСТ 20824 в три слоя.

Транзисторы могут эксплуатироваться при пониженном рабочем атмосферном давлении  $P \leq 335$  гПа (250 мм. рт. ст.) при соблюдении конструктивных мер, обеспечивающих непревышение предельно допустимых температурных режимов и исключающих коронный пробой. Зависимости напряжения сток – исток от рабочего атмосферного давления приведены на рисунке.

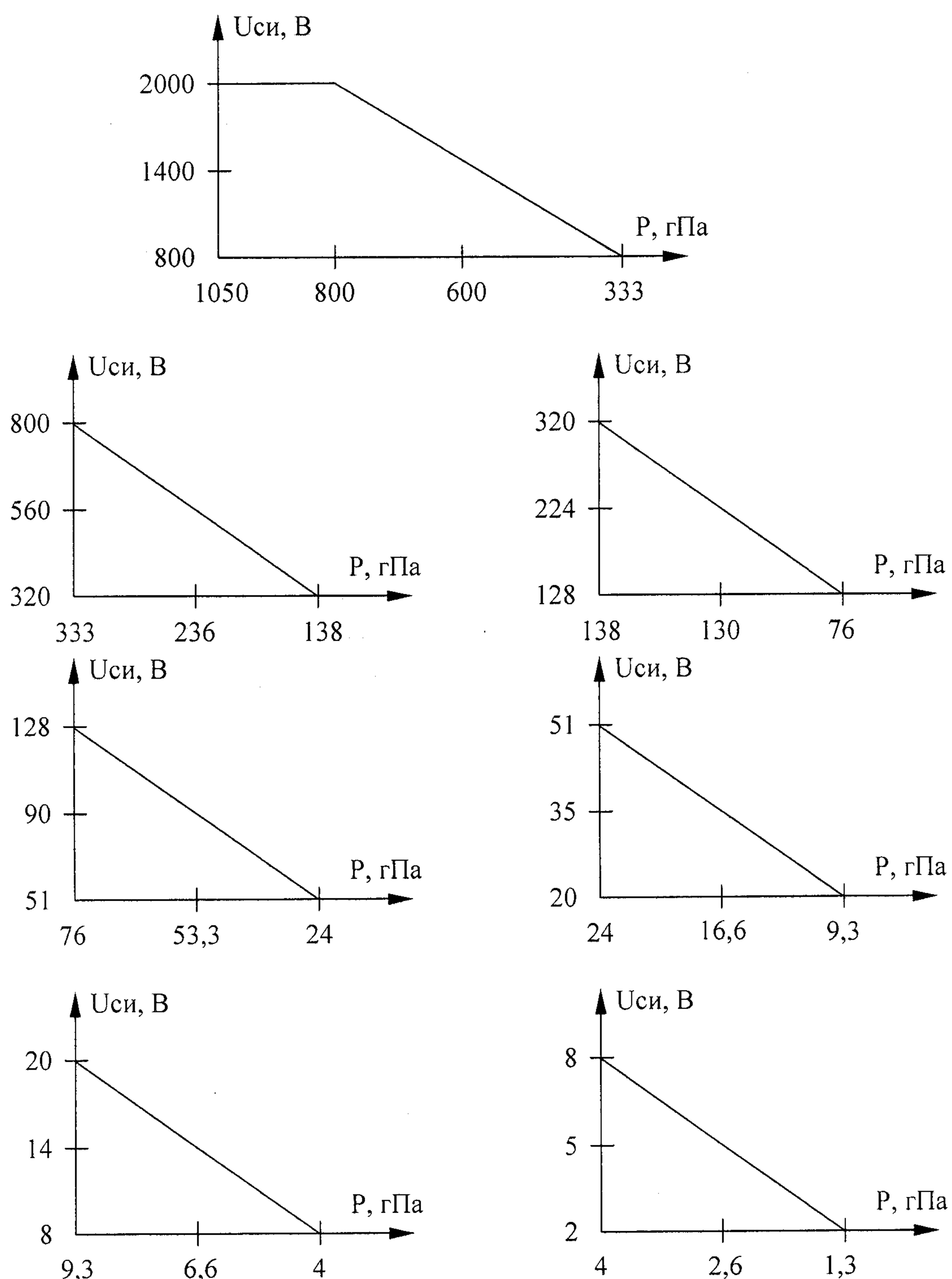
Рекомендуется установку и крепление транзисторов на платы проводить следующим образом:

- нанести на монтажные площадки платы флюс, затем припой;
- положить плату на печь с температурой  $(230 \pm 10)^\circ\text{C}$ ;
- положить на припой транзисторы, предварительно нагретые при температуре  $(150 \pm 10)^\circ\text{C}$  в течение 12 с и произвести притирку транзисторов по припою в течение (5 – 10) с;
- демонтаж транзисторов с платы производить на печи с вышеуказанной температурой.

Способ установки транзисторов на платы и их демонтаж должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

Транзисторы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки:

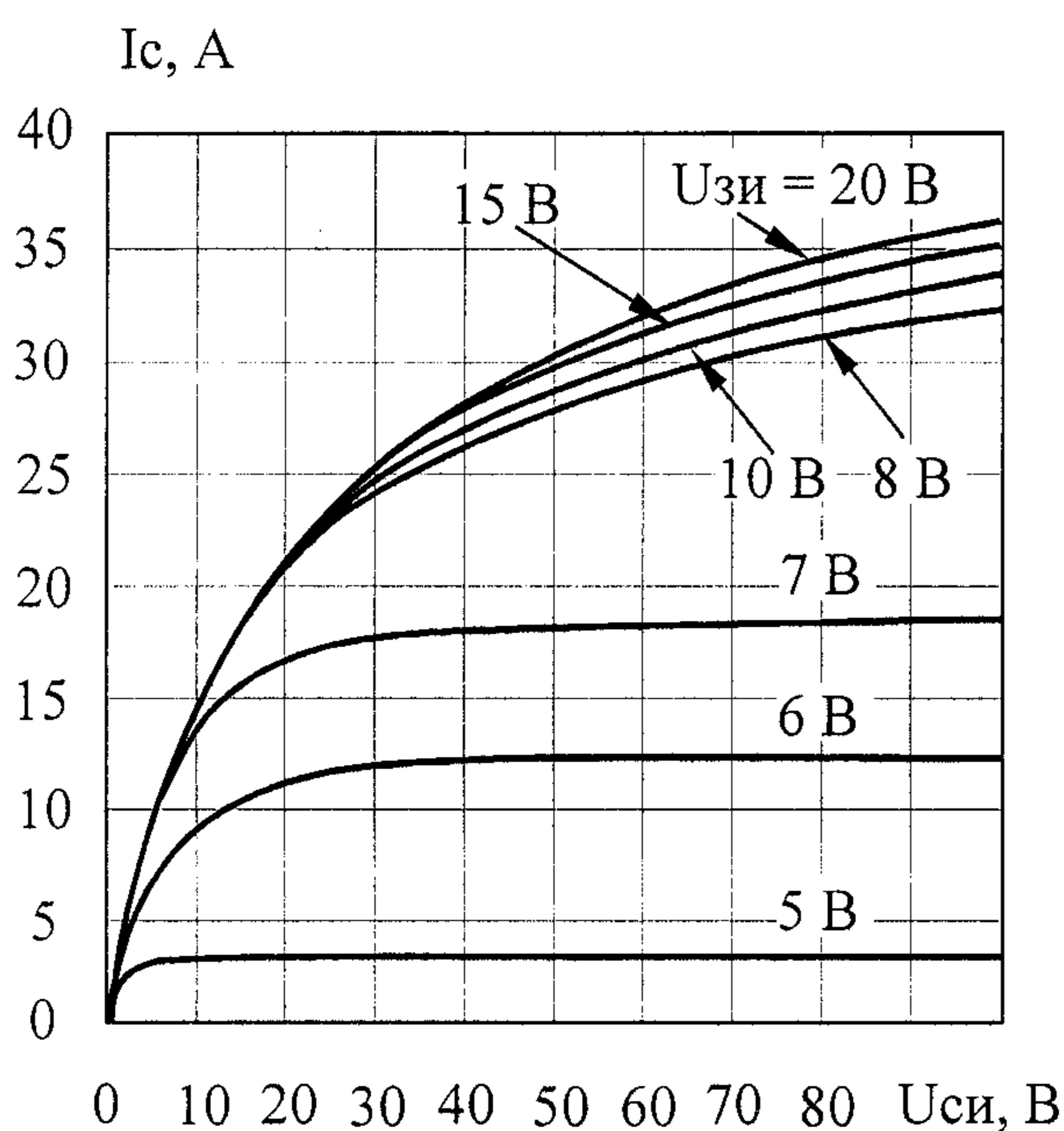
- температура нагрева транзистора не более  $265^\circ\text{C}$ ;
- время нахождения транзистора при температуре расплавленного припоя не более 1 мин;
- количество перепаек одного транзистора – не более трёх;
- интервал между пайками одного транзистора не менее 10 мин.



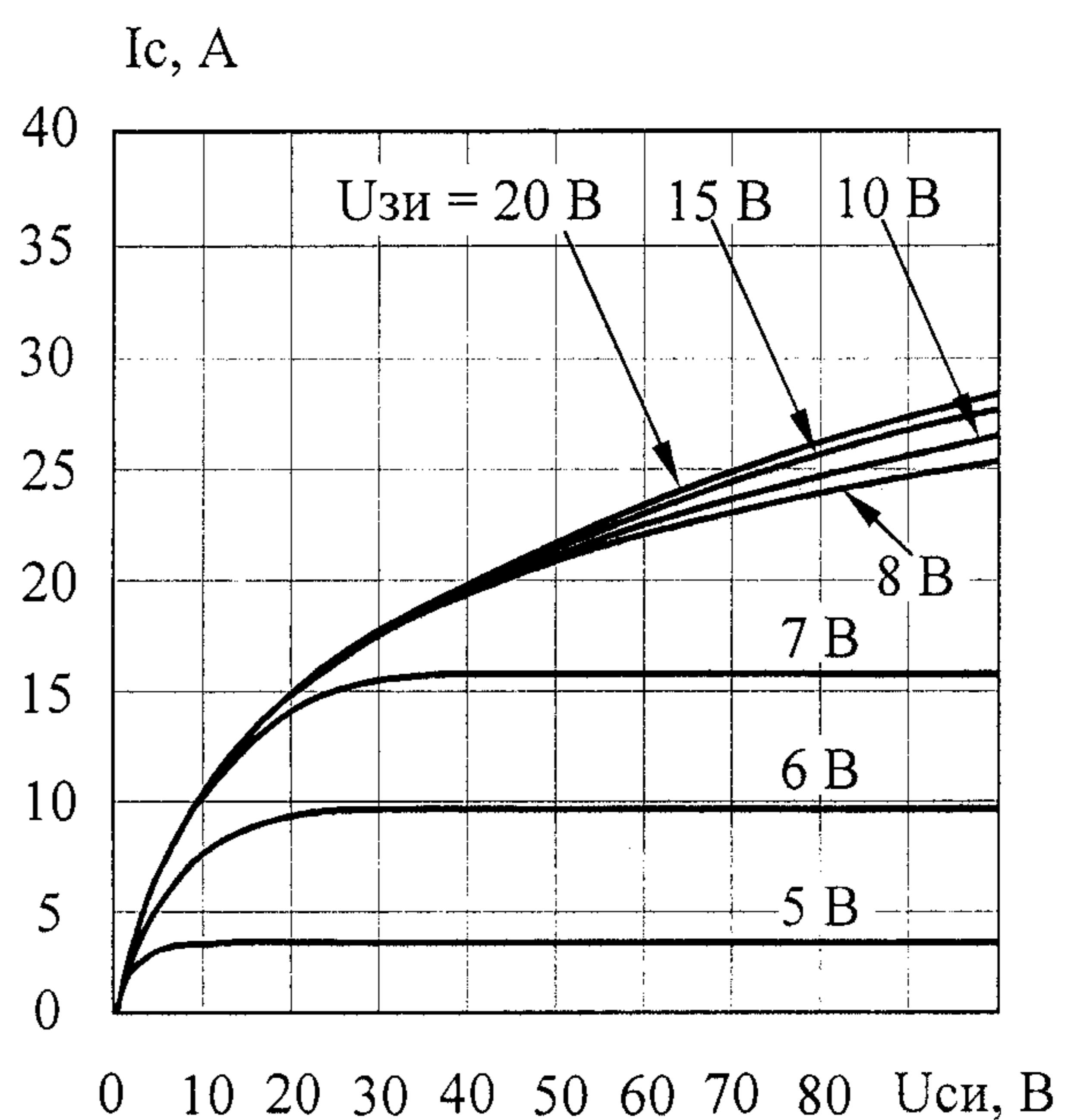
Зависимости максимально допустимого напряжения сток – исток от  
атмосферного давления (продолжение).

**КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ N КАНАЛЬНЫЕ  
ДМОП ТРАНЗИСТОРЫ**

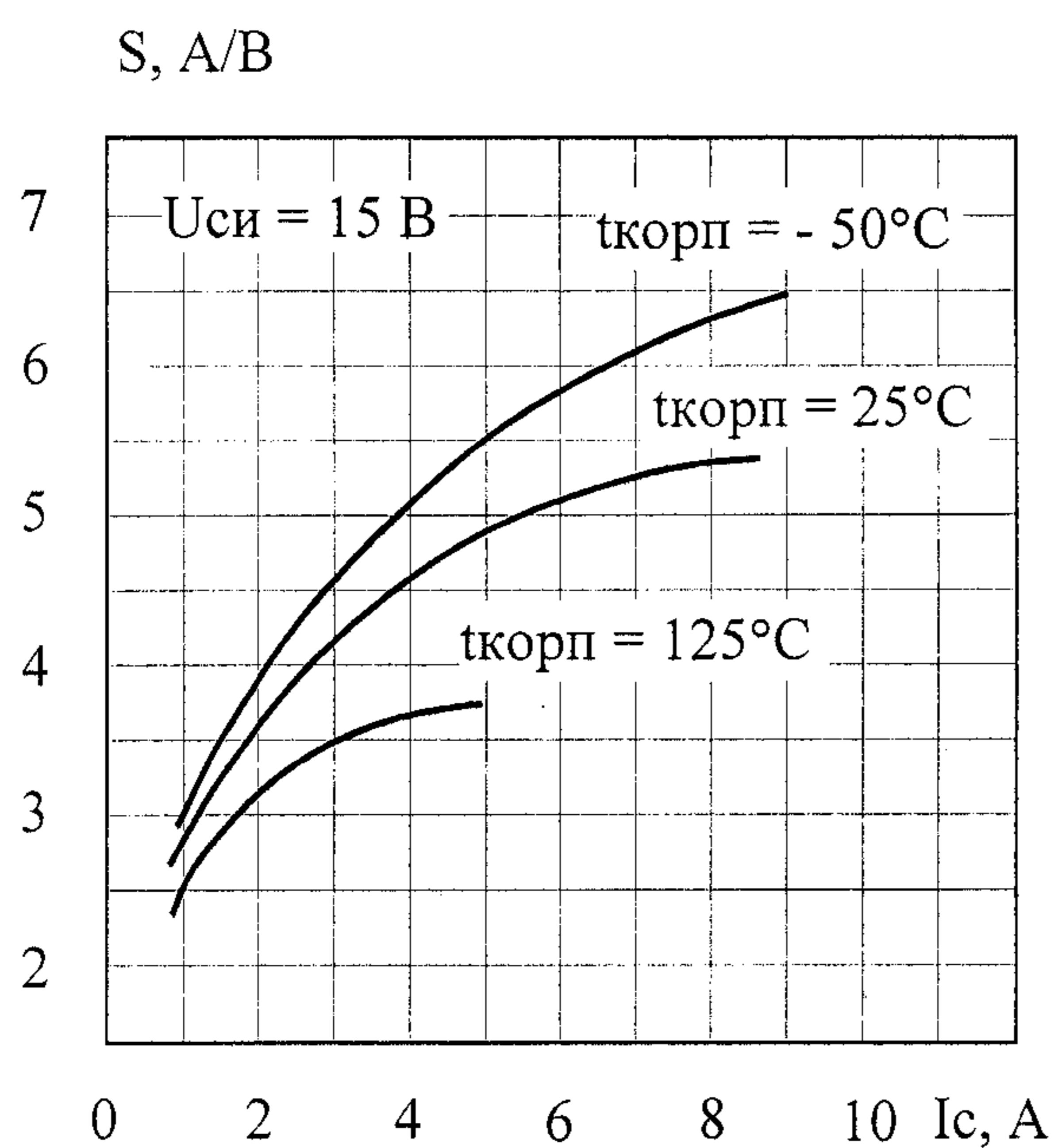
**2П820А9**



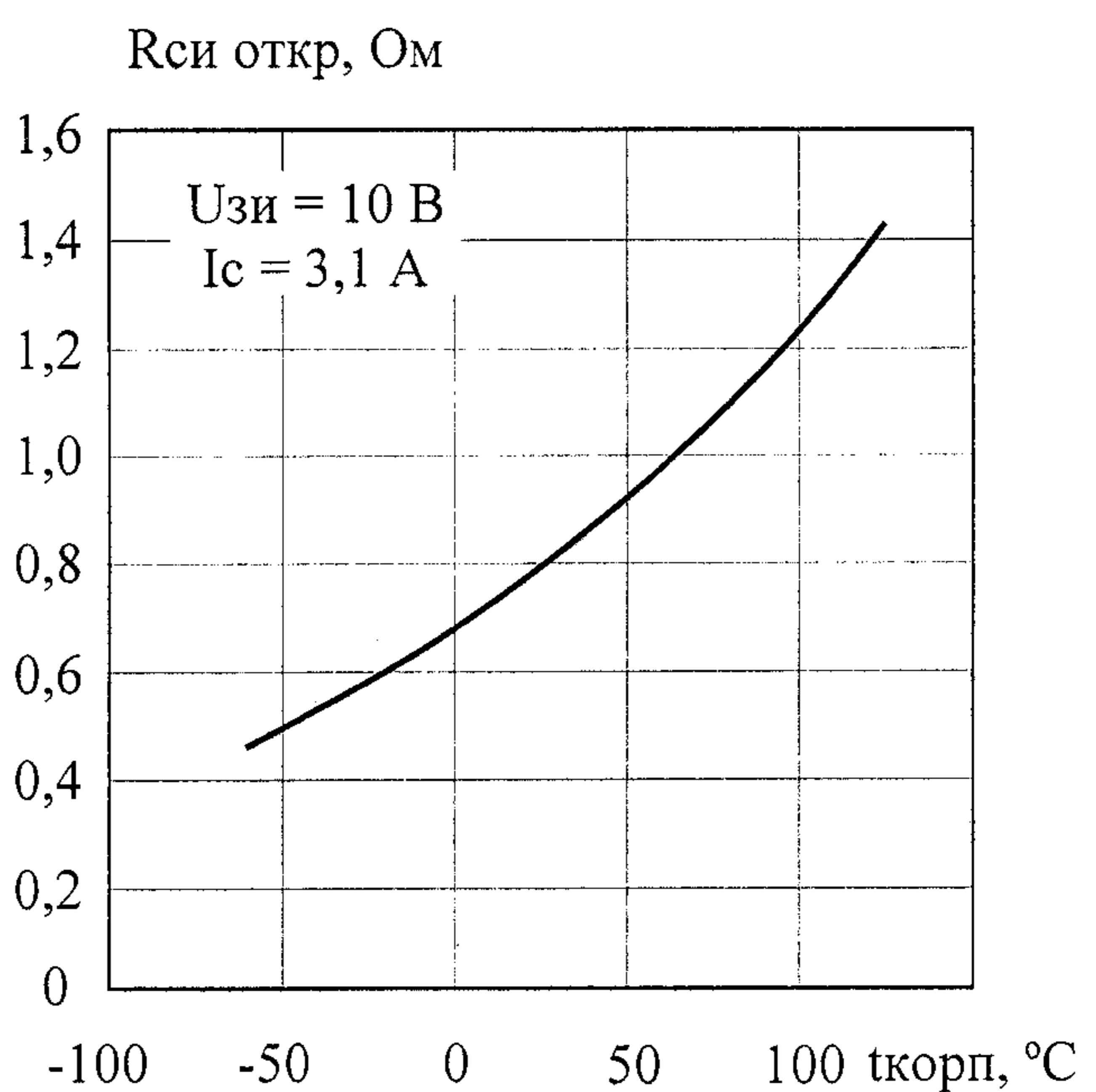
Типовые выходные характеристики транзистора при  $t_{корп} = 25^{\circ}\text{C}$ .



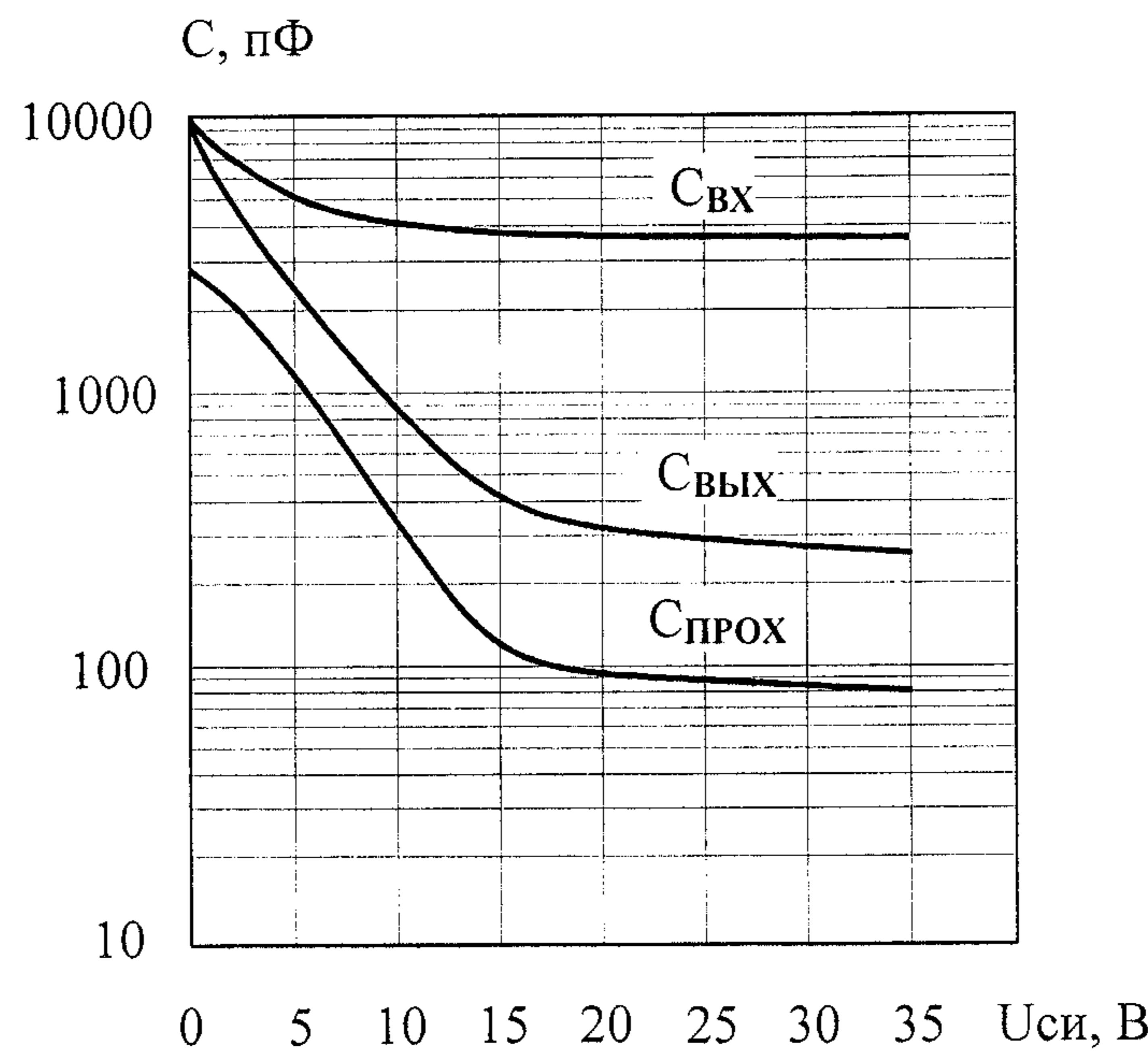
Типовые выходные характеристики транзистора при  $t_{корп} = 125^{\circ}\text{C}$ .



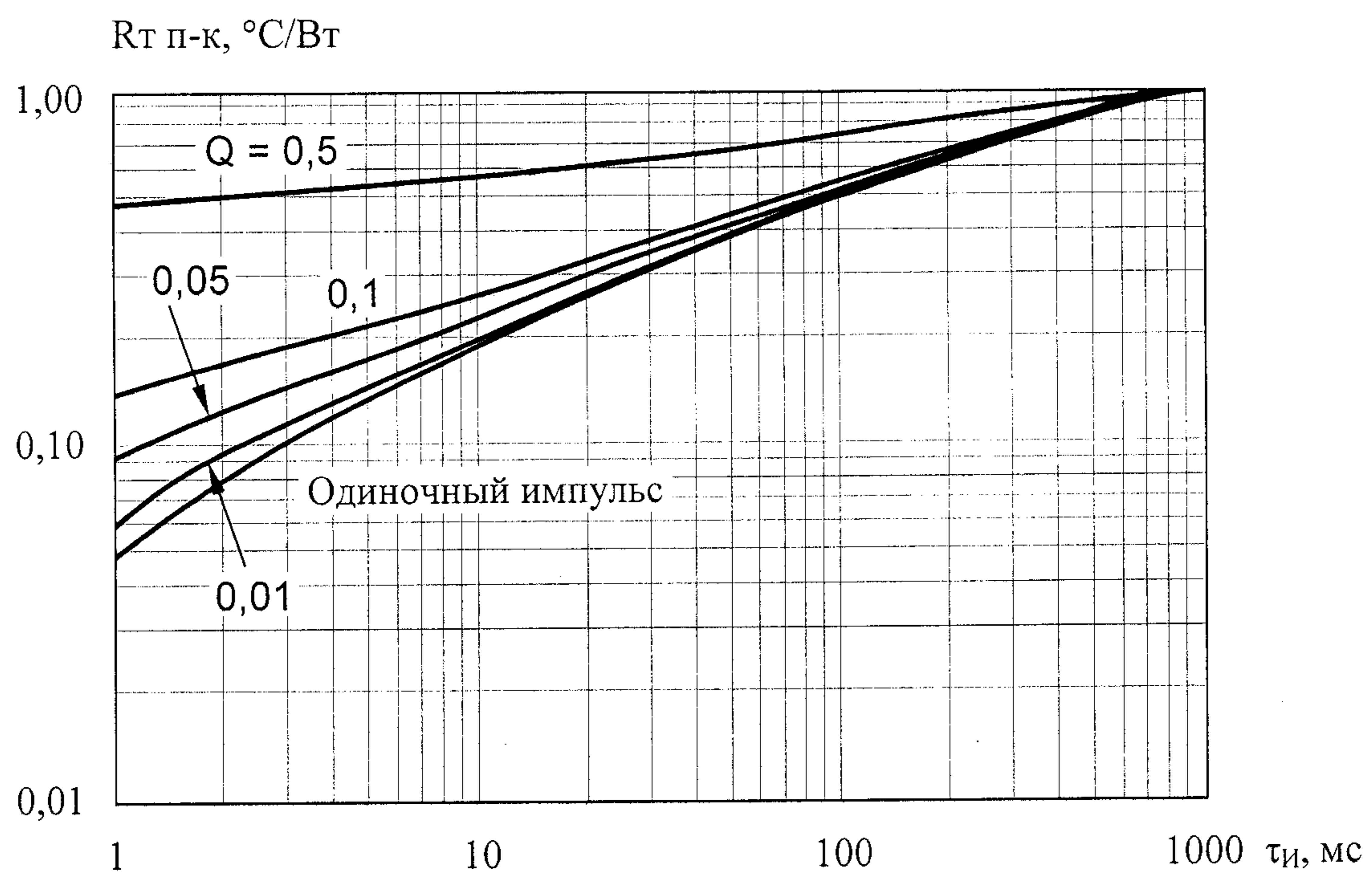
Типовые зависимости крутизны проходной характеристики транзистора от тока стока для разных значений температуры корпуса.



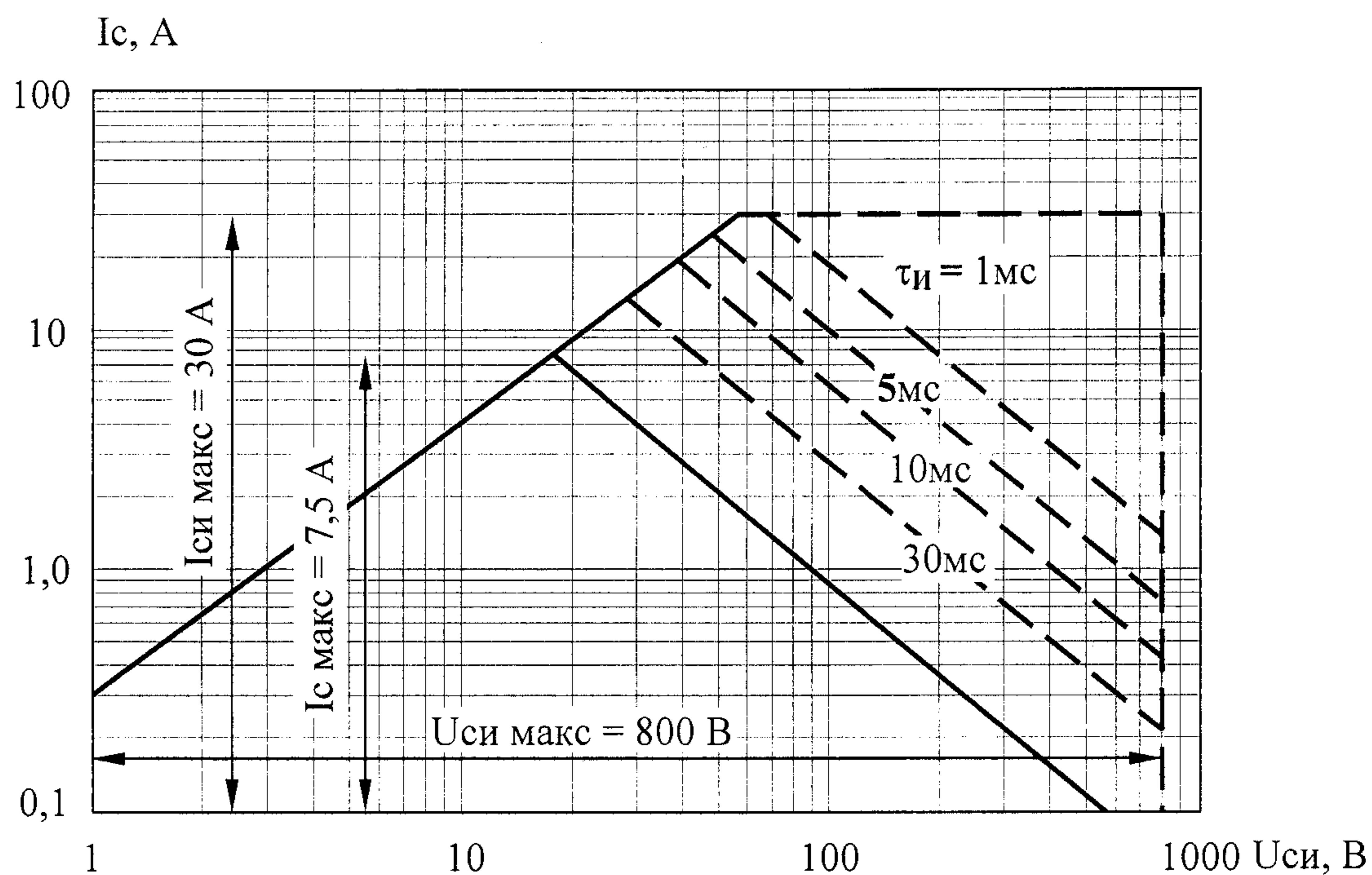
Типовая зависимость сопротивления сток – исток в открытом состоянии от температуры корпуса.



Типовые зависимости входной, выходной  
и проходной емкостей от напряжения сток - исток  
при  $f = 1 \text{ МГц}$ ,  $U_{зи} = 0$ ,  $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ .



Типовые зависимости теплового сопротивления переход - корпус транзистора от  
длительности импульса и скважности.



Область безопасной работы транзисторов в статическом и импульсном режимах при температуре корпуса  $t_{корп} = 25^\circ\text{C}$  и максимальной температуре перехода  $t_{\text{пп макс}} = 150^\circ\text{C}$ .

### 2П820Б9

Значения параметров и режимов, а также справочные данные и зависимости, установленные для транзисторов 2П820А9 соответствуют значениям параметров и режимов транзисторов 2П820Б9 за исключением характеристик стойкости к СВФ.